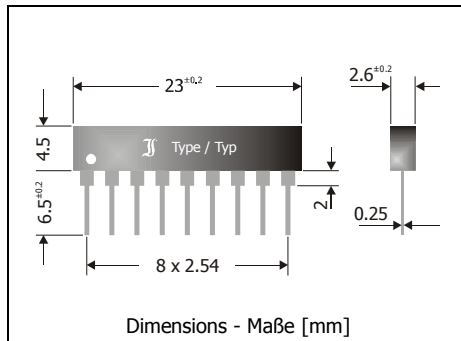


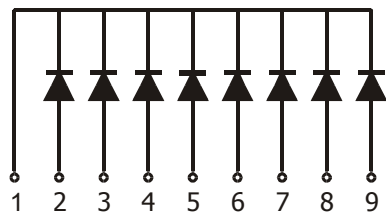
## DAF811A/K ... DAF814A/K (1.2 W)

### Rectifier Arrays Gleichrichtersätze

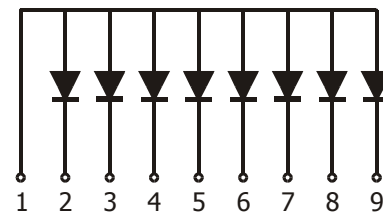
Version 2011-07-08



Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	100...400 V
9-pin Plastic case 9-Pin Kunststoffgehäuse	23 x 2.6 x 4.5 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



"DAF811K...DAF814K"  
common cathodes / gemeinsame Kathoden



"DAF811A...DAF814A"  
common anodes / gemeinsame Anoden

### Maximum ratings

### Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>1)</sup>	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V] <sup>1)</sup>
DA811A/K	100	120
DA814A/K	400	480

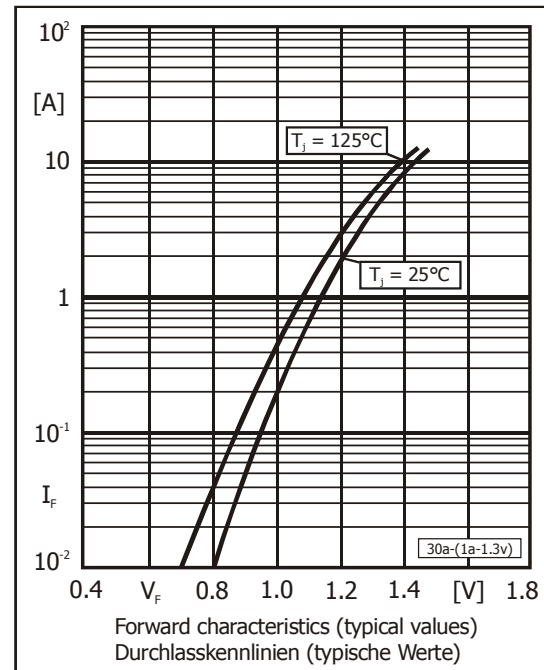
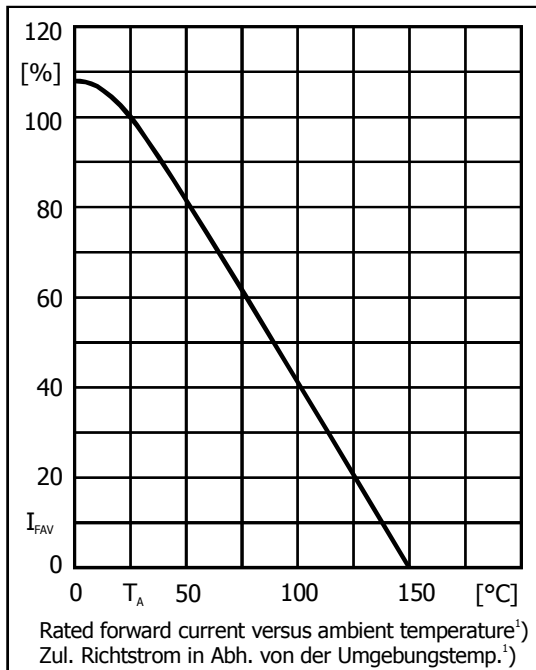
Max. power dissipation – max. Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	1.2 W <sup>1)</sup>
Max. average forward rectified current, R-load for one diode operation only for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	600 mA <sup>2)</sup> 150 mA <sup>2)</sup>
Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb beider Dioden	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	600 mA <sup>2)</sup> 150 mA <sup>2)</sup>
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	30 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_J$ $T_S$	-50...+150°C -50...+150°C

1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 1\text{ A}$	$V_F$	$< 1.3\text{ V}^{1)}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$ $I_R$	$< 10\ \mu\text{A}$ $< 90\ \mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to $I_R = 1\text{ mA}$	$t_{rr}$	$< 350\text{ ns}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		$R_{thJC}$	$< 85\text{ K/W}^{2)}$



1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden